

GaAs FET 低雑音増幅器

GaAs FET Low Noise Amplifiers

形名 Type	周波数 Frequency (MHz)	雑音指数 Noise Figure (dB max.)	利得 Gain (dB min.)	電源		入出力形状 Input/Output Connector	備考 Remarks
				電圧	電流		
				Input			
				Volt. (V)	Current (mA)		
NJS8300	3000-3100	2	15	5	20	SMA	
NJS8605	5400-5900	3	20	12	100	SMA	Include High Power Limiter
NJS8606	5400-5900	2.5	20	12	100	Waveguide	
NJS8701	6300-7100	3	20	12	75	SMA	
NJS8900	9300-9500	2.5	8	5	20	SMA	
NJS8901	9300-9500	2.5	18	5	50	SMA	
NJS8102	11700-12700	4	20	12	150	SMA	

GaAs FET 電力増幅器

GaAs FET Power Amplifiers

マイクロ波部品の固体化が常識となった近年、従来 TWTA の領域であった電力増幅器の分野にも GaAs FET の進歩に伴い、固体化が実現されています。

GaAs FET を用いた電力増幅器には、低雑音、低歪 (TWTA 出力の 6dB バックオフ相当)、高圧電源不要といった利点があります。

○当社 GaAs FET の特徴

- (1) L(D) バンドから Ku(J) バンド迄供給可能です。
- (2) 各バンド共にシステムに合わせた御要求に応じます。

Advances in GaAs FET technology now allow solid-state devices to replace vacuum tubes for some power amplification requirements.

GaAs FET power amplifiers have the advantage of low noise, very low distortion and low operating voltage.

○ Major features of New JRC GaAs FETs

- (1) L(D)-Band through Ku(J)-band can be supplied.
- (2) To match specific system requirements, models are available on request for any frequency band.

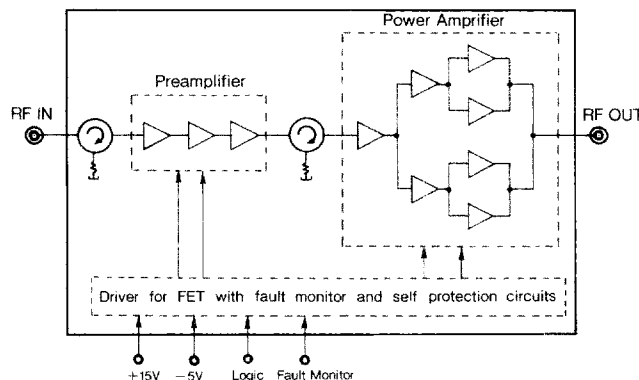


Fig3 Functional Block-Diagram

形名 Type	周波数 Frequency (MHz)	利得 Gain (dB TYP)	出力 Output Power (W min.)	電圧定在波比 V.S.W.R. In/Out	電源電圧 Input Volt. (V)
NJS8603	5030-5091	45	25	1.5/1.5	+15, -5
NJS8601	5400-5700	45	20	1.5/1.5	±15
NJS8000	9600-9800	30	1	1.5/1.5	±15

